

Micron collabora con Broadcom per risolvere la problematica relativa al DRAM Timing, consentendo ai clienti in rete di usufruire di prestazioni migliori

Una collaborazione focalizzata sui vincoli del Persistent DDR3 tFAW Timing

BOISE, Idaho, 17 dicembre 2013 (GLOBE NEWSWIRE) - Micron Technology Inc. (Nasdaq: MU), uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni avanzate per semiconduttori, ha oggi annunciato la sua collaborazione con Broadcom Corporation per sviluppare la prima soluzione nel settore orientata ai clienti che lamentano una problematica relativa ad una caratteristica di un parametro temporale delle memorie DDR3 chiamato tFAW, o four activate window.

tFAW si riferisce ad un parametro temporale DDR3 che limita il throughput dei dati in applicazioni di server, di storage e di rete e può compromettere la larghezza di banda dal 15 al 35 per cento. Con ogni nuova generazione DRAM, la granularità di accesso raddoppia, di conseguenza, i parametri di temporizzazione, come il tRDD ed il tFAW, limitano il throughput dei dati. Questo crea problemi per le applicazioni ad alte prestazioni poiché non possono essere emessi più di quattro comandi di tipo bank activate in ogni definito periodo tFAW.

"La ricerca di migliori prestazioni da parte dei fornitori di rete rimane una sfida irrisolta nel bel mezzo di un sovraccarico continuo di dati", ha dichiarato Mike Howard, senior principal analyst del gruppo DRAM e memorie di IHS iSuppli. "Le soluzioni di architettura in grado di incrementare la larghezza di banda per le applicazioni ad alte prestazioni serviranno ad estendere l'efficienza operativa ed a migliorare le prestazioni complessive della rete".

Secondo il Visual Networking Index di Cisco(R), il traffico IP globale tra il 2012 ed il 2017 è destinato a crescere ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 23 per cento.

Per soddisfare questo enorme appetito di larghezza di banda, i service provider di tutto il mondo fanno a gara per trasformare le loro reti, adottando dei collegamenti con una maggiore larghezza di banda.

La soluzione di Micron, convalidata da Broadcom, riduce il valore tFAW da 35ns a 30ns per una pagina con una dimensione di 2KB, DDR3-2133, migliorando le operazioni per secondo del 18 per cento. Questo aumento di prestazioni è particolarmente critico per le funzioni di elaborazione di pacchetti complessi,

come le ricerche altamente scalabili IPv4 e IPv6 utilizzate in applicazioni di servizio di rete del provider. La soluzione four activate window consente all'BCM88030 200 Gb/s NPU di Broadcom di ottenere delle capacità di ricerca dell'L2, IPv4 e IPv6 estremamente scalabili con prestazioni a livello di wire-speed, utilizzando le memorie DDR3 di Micron.

"Gli OEM oggi continuano ad affrontare la sfida di un volume, velocità e varietà di dati sempre crescenti", ha detto Robert Feurle, vicepresidente del gruppo DRAM marketing presso Micron. "Siamo felici di lavorare con Broadcom per convalidare una soluzione che aiuti ad alleviare la sfida di throughput per i nostri comuni clienti".

"Broadcom è impegnata a fornire capacità ad elevata larghezza di banda e di scala per soddisfare le esigenze aggressive delle reti della prossima generazione", ha dichiarato Dan Harding, senior director del gruppo product marketing, compute & connectivity di Broadcom. "Attraverso la nostra collaborazione con Micron, possiamo continuare il nostro impegno nel fornire le soluzioni NPU più scalabili nel settore".

Disponibilità

Le DDR3 da 2Gb e 4Gb di Micron con un ridotto tFAW Timing sono ora disponibili in produzione in volumi.

Micron, un partner impegnato nel mercato del networking, gode di una lunga collaborazione con clienti e partner, fornendo soluzioni di memoria e sistemi che accelerano l'infrastruttura della rete che collega il nostro mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito micron.com.

Informazioni di carattere generale sulla Micron Technology, Inc.

Micron Technology, Inc., è leader mondiale nei sistemi di semiconduttori avanzati. L'ampio portafoglio di tecnologie di memoria ad alte prestazioni di Micron - tra cui DRAM, NAND e NOR Flash - è la base per le unità a stato solido, moduli, pacchetti multichip e altre soluzioni di sistema. Sostenuta da oltre 35 anni di leadership tecnologica, le soluzioni di memoria di Micron consentono le elaborazioni più innovative al mondo, prodotti consumer, enterprise storage, networking, applicazioni mobili, embedded e automobilistiche. Le azioni ordinarie della Micron sono quotate al NASDAQ con il simbolo MU. Per ulteriori informazioni su Micron Technology Inc., visitare il sito www.micron.com.

CONTATTO: Zeno Group for Micron

Mary Ellen Ynes

maryellen.ynes@zenogroup.com

650-801-7954